

M1F □

800V 1A

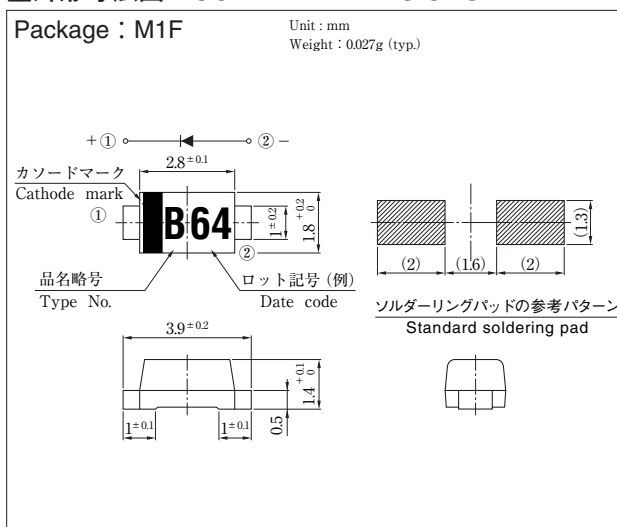
特長

- 耐湿性に優れ高信頼性
- 自動実装対応

Feature

- High-Reliability
- for Auto-Mount

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

定格表 RATINGS

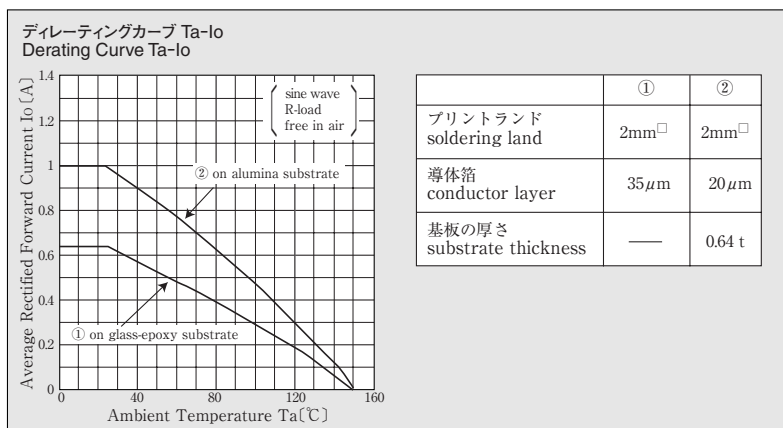
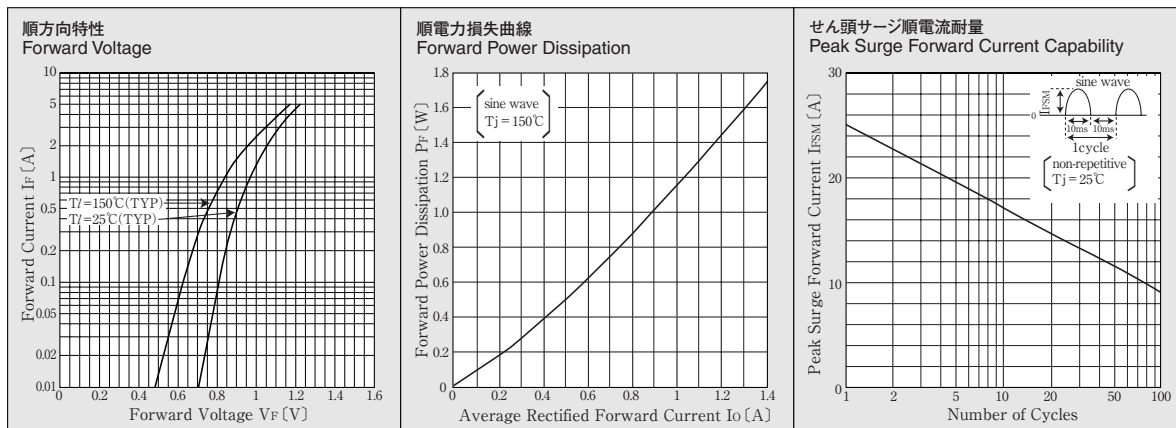
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	M1F60	M1F80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			- 55 ~ 150		℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150		℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, Ta=25℃ 50Hz sine wave, Resistance load, Ta=25℃	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1		A
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	0.64		
せん頭サーージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25℃		25		A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =1A, パルス測定 Pulse measurement		MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =V _{RM} , パルス測定 Pulse measurement		MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead		MAX 20	℃/W
	θ_{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	MAX 108	
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	MAX 186	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.